

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ****Mã hồ sơ:.....**

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Quang học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Đặng Hữu Phúc

2. Ngày tháng năm sinh: 13/09/1987; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Mỹ Thạnh Trung, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 31/1 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 31/1 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0909041387;

E-mail: danghuuphuc@iuh.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ 09/2010 đến 06/2018: Giảng viên trung tâm giáo dục thường xuyên, tại trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 06/2018 đến 12/2021: Giảng viên khoa khoa học cơ bản tại trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 12/2021 đến 06/2025: Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục học, khoa Khoa Học Cơ Bản tại trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ nhiệm bộ môn

Cơ quan công tác hiện nay: trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028 38940 390

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 08 tháng 09 năm 2009, số văn bằng: 083VL/09-2009, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Tp HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 18 tháng 06 năm 2013, số văn bằng: 348-VL/2013, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Quang học

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Tp HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 20 tháng 11 năm 2018, số văn bằng: 21-TS/2018/1332103, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Quang học

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Tp HCM

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

1- Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu hấp thụ ánh sáng để ứng dụng cho các thiết bị chuyển đổi năng lượng quang thành năng lượng điện:

-Nghiên cứu cơ bản tính chất tổng quát của oxit dẫn điện trong suốt hướng đến ứng dụng trong các thiết bị liên quan đến cơ chế chuyển đổi quang thành điện.

-Pin mặt trời chấm lượng tử nhảy quang QDSSCs bằng cách tối ưu hóa các thành phần của bao gồm chấm lượng tử (CdS, CdSe, ZnS, ZnSe), điện cực đối (như rGO, Cu₂S, PbS), và lớp vận chuyển điện tử nền SnO₂.

2-Phát triển vật liệu nano (ZnO, Cu₂O, Bi₂S₃, ZnCo₂O₄) và cấu trúc dị thể tiếp xúc p-n để phân hủy chất ô nhiễm (methylene blue, ofloxacin, indigo carmine) dưới ánh sáng khả kiến.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 50 bài báo khoa học, trong đó 44 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở	Cấp trường	2021
2	Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở	Cấp trường	2022
3	Đề tài cấp tỉnh/thành phố trở lên có kết quả nghiệm thu xuất sắc	Cấp trường	2021

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Tôi tự nhận thấy bản thân có đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo theo nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo tại điều 69, 70 của Luật Giáo dục; các quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động KHCN tại điều 20, 21 của luật Khoa học và Công nghệ.

Về tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng; chấp hành tốt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác đào tạo: thực hiện biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ đào tạo; hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp đại học và học viên cao học làm luận văn thạc sĩ; luận án tiến sĩ.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Tôi được đào tạo theo hệ chính quy từ Đại học ngành Vật lý chất rắn, Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Vật lý - Quang học. Trong thời gian làm luận án Tiến sĩ, tôi theo đuổi hướng nghiên cứu về Quang học – vật liệu bán dẫn tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM, đại học Quốc Gia Tp HCM. Sau khi nhận được bằng Tiến sĩ, tôi tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu này tại Khoa khoa học Cơ Bản và Khoa Công Nghệ Hóa Học, Trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM. Ngoài ra, tôi cũng phối hợp thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ cùng với nhóm nghiên cứu của Phòng Vật lý chân không - Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM, đại học Quốc Gia Tp HCM.

Là trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng từ 2021, thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ, làm chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu chính của các đề tài KH&CN các cấp; kết nối và hỗ trợ các thành viên trong nhóm nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 7 năm 0 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2019-2020					266		266/298.2/270
2	2020-2021					330	30	360/456/270
3	2021-2022				5	300	30	330/418.93/243
03 năm học cuối								
4	2022-2023				4	296	30	326/413.4/236
5	2023-2024			1		330	30	360/432/256
6	2024-2025			2	3	298	30	328/407.4/256

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn

giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☐:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☐ hoặc TSKH ☐; Tại nước: năm

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC 630

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVC H/CK 2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Quách Uy Lập		X		X	06/2022 đến 11/2022	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Tp HCM	12/09/2023
2	Nguyễn Thị Hoài Phương		X	X		04/2024 đến 11/2024	Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, đại học Quốc Gia Tp HCM	15/04/2025
3	Đặng Linh Chi		X	X		04/2024 đến 11/2024	Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, đại học Quốc Gia Tp HCM	2025

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							

1	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học	GT	Đại học Công Nghiệp Tp HCM, năm 2021	2	VC	(115-124)	2964/QĐ-ĐHCN
---	--------------------------------------	----	--------------------------------------	---	----	-----------	--------------

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/T K	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu và tối ưu tính chất cấu trúc, quang và điện của màng bán dẫn loại p SnO ₂ pha tạp đơn nguyên tố và đồng pha tạp hai nguyên tố: hướng đến khảo sát thử nghiệm hiệu ứng quang điện của tiếp giáp SnO ₂ pha tạp/n-Si	CN	103.03-2019.04, cấp Bộ	05/09/2019 đến 19/07/2021	27/12/2021 – Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	The influence of deposition temperature and annealing temperature on Ga-doped SnO ₂ films prepared by direct current magnetron sputtering	4	Có	Journal of Alloys and Compounds	- - SCIE IF: 6.614, Q1	40	687 1012-1020	07/2016

2	The Optimum Fabrication Condition of p-Type Antimony Tin Oxide Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering	4	Có	Journal of Nanomaterials	Có - SCIE IF: 4.138, Q2	14	2016, Article ID 7825456	05/2016
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
3	Eliminating the charge compensation effect in Ga-doped SnO ₂ films by N doping	4	Có	Journal of Alloys and Compounds	- - SCIE IF: 6.614, Q1	9	776 276-286	10/2018
4	Studying the influence of deposition temperature and nitrogen contents on the structural, optical, and electrical properties of N-doped SnO ₂ films prepared by direct current magnetron sputtering	4	Có	Ceramics International	- - SCIE IF: 5.884, Q1	11	Volume 45, Issue 7, Part A,, Pages 9147-9156	03/2019
5	Effect of Sn-substituted Ga and in dopant content on the structural, electrical, and optical properties of p-type X-doped SnO ₂ (X = Ga and In) films: Testing the photoelectronic effect of X-doped SnO ₂ /n-Si junctions	4	Không	Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry	- - SCIE IF: 4.874, Q2	10	Volume 376 Pages 88-99	03/2019
6	Studying and fabricating optical, electrical, and	3	Không	Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry	- - SCIE IF: 4.874, Q2	10	Volume 390,, 112334	12/2019

	structural properties of p-type Al- and N-co-doped SnO ₂ (ANTO) films and investigating the photo-electro effect of p-ANTO/n-Si heterojunctions							
7	Effect of N solubility in the SnO ₂ host lattice on the structural, electrical, and optical properties of p-type Ga- and N-co-doped SnO ₂ (GNTG) films	6	Không	Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry	- - SCIE IF: 4.874, Q2	2	Volume 400, 112708	06/2020
8	Effect of the Sb content in the SnO ₂ lattice and N ₂ percentage in a mixed sputtering gas on the N solubility in SnO ₂ films	2	Không	Sensors and Actuators A: Physical	- - SCIE IF: 5.405, Q1	3	Volume 316, 112421	11/2020
9	Investigating N solubility in the host lattice of p-type Al- and N-co-doped SnO ₂ films with various N ₂ contents in sputtering gas,	5	Không	Optical Materials,	- - SCIE IF: 4.733, Q1	7	Volume 111 110665	01/2021
10	Optical, electrical, and structural properties of Ta-doped SnO ₂ films against substrate temperature using direct current magnetron sputtering	4	Không	Surfaces and Interfaces	- - SCIE IF: 6.602, Q1	8	Volume 23, 100943	01/2021

11	Effects of Zn and Zn–N doping on optical, electrical, and structural properties of p-type SnO ₂ films	4	Không	Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry	- - SCIE IF: 4.874, Q2	8	Volume 418, 113436	07/2021
12	High-efficiency quantum dot sensitized solar cells based on flexible rGO-Cu ₂ S electrodes compared with PbS, CuS, Cu ₂ S CEs,	6	Không	Solar Energy Materials and Solar Cells	- - SCIE IF: 6.882, Q1	15	Volume 250, 112042	11/2022
13	Incorporation of N in p-type Zn–N-doped SnO ₂ films by varying N ₂ content in sputtering gas mixture	6	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	- - SCIE IF: 5.005, Q1	1	Volume 155, 107230	11/2022
14	Improving structural and electrical properties of p-type Al–N-doped SnO ₂ films with low Al content by tuning N ₂ concentration in sputtering gas mixture	4	Không	Physica B Condens Matter	- - SCIE IF: 3.093, Q2	2	Volume 650,, 414542	12/2022
15	One-step hydrothermal preparation of Ta-doped ZnO nanorods for improving decolorization efficiency under visible light	6	Không	RSC Advances	- - SCIE IF: 4.733, Q1	13	13 5208–5218	01/2023
16	Effect of the calcination temperature of the FTO/PbS cathode on the performance of	3	Không	AIMS Materials Science	- - Scopus IF: 2.155, Q3		Volume 10, Issue 3:, 426-436	05/2023

	a quantum dot-sensitized solar,							
17	A novel n-p heterojunction Bi ₂ S ₃ /ZnCo ₂ O ₄ photocatalyst for boosting visible-light-driven photocatalytic performance toward indigo carmine	5	Không	RSC Advances	- - SCIE IF: 4.733, Q1	6	Issue 24, 2023 16248–16259	05/2023
18	Investigations on structural, photoluminescence, and photometric properties of poly(vinyl alcohol)-capped Mn doped-ZnO nanoparticles for white light emission	4	Không	Optical Materials	- - SCIE IF: 4.411, Q1	8	Volume 143, 114145	07/2023
19	Optimizing electrical-optical parameters in TiO ₂ @CdS@Cd _x Cu _{1-x} Se photoanodes using UV-Vis spectra, J-V curves, and EIS experiments in quantum dot-sensitized solar cells	7	Không	Optical and Quantum Electronics	- - SCIE IF: 4.583, Q2		Volume 55, article number 1221	11/2023
20	Starch Assisted the ZnS Buffer Layer in Enhancing the Photoluminescence of ZnSe/ZnS:Mn/ZnS Quantum Dots for Detecting E. Coli and MRSA Bacteria Quickly	5	Có	Journal of Fluorescence	- - SCIE IF: 3.589, Q3	2	Volume 35, pages 99–110	11/2023

21	Novel n-p Photocatalysts Heterojunction via ZnO Nanoparticles Decorated ZnCo2O4 as an Improved Visible-Light-Driven Decomposition of Methylene Blue and Antimicrobial Activity	5	Có	Arabian Journal for Science and Engineering	- - SCIE IF: 3.696, Q1	5	Volume 49, pages 7961–7977	12/2023
22	Studying the structural, optical, and electrical characteristics of Zn2SnO4 films using a direct current magnetron sputtering method	5	Có	Ceramics International	- - SCIE IF: 5.884, Q1	1	Volume 50,, Issue 4, Pages 6824-6835	01/2024
23	Highly catalytic reduced graphene oxide decorated Cu2S counter electrode boosting quantum dot-sensitized solar cell performance	6	Có	Physica Scripta	- - SCIE IF: 2.681 Q2	4	99 025992	01/2024
24	Enhanced photoelectrochemical performance of quantum dot-sensitized solar cell using Cu2+ co-doped CdS and CdSe nanocrystals	5	Có	Royal Society Open Science	- - SCIE IF: 2.995 Q1		11 231343	01/2024
25	Novel photocatalyst for dye degradation: Cu2O/Ag2MoO4	9	Không	Journal of Molecular Liquids	- - SCIE IF: 5.788 Q1	13	Volume 398, 124261	02/2024

	nanocomposite on cellulose fibers from recycled cigarette butts							
26	Synthesization pill-like C-doped ZnO nano-photocatalyst for removing ofloxacin and methylene blue under visible light,	6	Không	Journal of Sol-Gel Science and Technology	- - SCIE IF: 3.197, Q2	7	Volume 110 pages 204–220	06/24
27	Elucidating the synthesis mechanism, characterization, and colorimetric sensor applications of biogenic gold nanoparticles derived from Cassia grandis fruit extract	9	Không	Biochemical Engineering Journal	- - SCIE IF: 4.373 Q2	3	Volume 207 109335	04/2024
28	Efficient Light Absorption Using ZnS doped on metal for quantum dot-sensitized solar cell	6	Có	Optical and Quantum Electronics	- - SCIE IF: 4.583, Q2		Volume 56 article number 1073	05/2024
29	Silver nanoparticles embedded on magnetite-coated UiO-66 microspheres for enhanced nitroarene reduction	8	Không	Advanced Powder Technology	- - SCIE IF: 4.523, Q1	2	Volume 35,, Issue 6,, 104488	05/2024
30	Enhanced luminescence using the core-shell-shell structure of 3-mercaptopropionic acid-capped ZnSe/ZnS:	5	Không	Journal of the Chinese Chemical Society	- - SCIE IF: 1.534, Q3	1	Volume 71, Issue 7, Pages 662-671	05/2024

	Mn/ZnS quantum dot							
31	Effect of hydrothermal time on catalyst activity of counter electrode Cu ₂ S-rGO composite to enhance the efficiency of quantum dot solar cells	7	Có	Ceramics International	-- SCIE IF: 5.884, Q1	1	Volume 50, Issue 15, Pages 27127-27138	05/2024
32	Enhancing Absorption of Photon Using ZnSe Doped Copper as a Passivation Layer for Quantum Dot Solar Cell	5	Không	Arabian Journal for Science and Engineering	-- SCIE IF: 3.696, Q1		Volume 50 pages 6779–6787	06/2024
33	Rapid Synthesis of Bismuth MOF @Carbon Nanotube Composite by microwave-assisted Solvothermal for Photodegrading RhB	5	Không	Topics in Catalysis	-- SCIE IF: 3.035, Q2	2	67 1155–1168	07/2024
34	Construction of nickel foam-supported carbon spheres doped with copper nanoparticles for efficient nitrophenol reduction	8	Không	Materials Today Communication	-- SCIE IF: 4.809, Q2	1	Volume 41, 110678	11/2024
35	Synthesis of ZnO nanoparticles-based fluorescent ink for information encryption and security applications	4	Không	Optical Materials	-- SCIE IF: 4.411, Q1	1	Volume 157, Part 2, 116296	11/2024

36	Efficient counter electrode for quantum dot sensitized solar cells using p-type PbS@reduced graphene oxide composite	7	Có	Nanoscale Advances	-- SCIE IF: 4.687, Q1	1	Issue 3, 2025 700-710	12/2024
37	Synthesis of calcined LDHs materials decorated on ZnO nanorods: enhancing adsorption capacity and antibacterial activity	5	Không	Environmental Science: Advances	-- Scopus IF: 4.944, Q1		4 663-675	02/2025
38	Effect of the Dimethylformamide/Isopropanol Solvent Ratio on the Structure, Optical Properties, and Photodegradation Performance of RhB Using Bi-MOF	5	Không	Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis	-- Scopus IF: 1.588, Q3		Volume 20, Issue 1, 166-176	04/2025
39	A novel 3D Fe ₂ O ₃ @ZnBi ₂ O ₄ n-p heterojunction with high photocatalytic activity under visible light	7	Không	Nanoscale Advances	-- SCIE IF: 4.687, Q1		7, 2942-2954	02/2025
40	Ảnh hưởng bề dày đến cấu trúc và tính chất quang điện của màng SnO ₂ pha tạp N	3	Không	VNUHCM Journal - Engineering and Technology			Vol 2 No 4 (2019) 240-245	02/2020
41	Ảnh hưởng pha tạp N đến tính chất cảm biến quang của cấu trúc dị thể p-SnO ₂ đồng pha	2	Có	Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)			Vol 5 No 2 (2021), 1157-1166	04/2021

	tạp Zn và N/ n-Si							
42	Ảnh Hưởng Phần Trăm Pha Tạp Ga Lên Cấu Trúc Tinh Thể Và Tính Chất Quang Điện Của Màng SnO ₂ :Ga (GTO)	4	Có	Hội Nghị" Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications X, 2018			95-99, (2018)	11/2018
43	Đặc trưng photodiode của cấu trúc In/p-SnO ₂ :N/n-Si/In ảnh hưởng bởi phần trăm N pha tạp	6	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			273-277	11/2019
44	Tính Chất Dẫn Điện Loại P Của Màng SnO ₂ Đồng Pha Tạp N-Zn	5	Có	Hội Nghị" Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XI,			190 - 194,	11/2020
45	Tăng cường hiệu suất pin mặt trời chấm lượng tử bằng cách sử dụng tổ hợp các vật liệu Cu ₂ S và Graphene oxit dạng khử trong điện cực âm Cathode	5	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2023			151-154	11/2023
46	Tunable Optical and Photoluminescence Properties of Metal X (Ni, Co, Mn, Ag)-Doped ZnSe Quantum Dots: Structural, Spectroscopic, and Colorimetric Analysis	5	Không	Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis	-- Scopus IF: 1.588, Q3		Volume 20, Issue 2	04/2025
47	Silver nanoparticle-decorated nanorod bismuth based -	5	Có	Materials Science and Technology	-- SCIE IF: 2.213, Q2		1–14	04/2025

	organic framework/graphitic carbon nitride composite for enhanced reactive blue 19 degradation under visible light							
48	Enhancement of carbon quantum dot luminescence efficiency through N, S co-doping for rapid ion Fe ³⁺ detection	4	Có	Optical and Quantum Electronics	- - SCIE IF: 4.583, Q2		57 (2025) article number 291	05/2025
49	Synergistic enhancement of charge transfer and catalytic activity in CNT@rGO@Cu ₂ S composite counter electrodes for high-performance quantum dot-sensitized solar cells	4	Có	RSC Advances	- - SCIE IF: 4.733, Q1		15 (2025) 14463–14476	05/2025
50	Optimizing hydrothermal synthesis temperature for enhanced morphology and electrochemical performance of rGO@Cu ₂ S counter electrodes in quantum dot sensitized solar cells	4	Có	Physica Scripta	- - SCIE IF: 2.681 Q2		Volume 100, Number 7, 075928	06/2025

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 14 ([3] [4] [20] [21] [22] [23] [24] [28] [31] [36] [47] [48] [49] [50])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: 0 / []

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☒

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Studying and fabricating optical, electrical, and structural properties of p-type Al- and N-co-doped

SnO₂ (ANTO) films and investigating the photo-electro effect of p-ANTO/n-Si heterojunctions

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UỶ chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UỶ chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UỶ không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UỶ không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Hữu Phúc